


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		



УТВЕРЖДЕНО
 решением Ученого совета ИФФВТ
 от 17 мая 2022 г. протокол №10/18-05-22
 Председатель (Рыбин В.В.)

(подпись, расшифровка подписи)

« 17 » мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Диагностика полупроводниковых структур
Факультет	Инженерно-физический факультет высоких технологий
Кафедра	Кафедра физического материаловедения
Курс	4

Направление (специальность): **28.03.02 «Наноинженерия» (бакалавриат)**
(код направления (специальности), полное наименование)

Направленность (профиль/специализация): **Нанотехнологии и наноматериалы**
(полное наименование)

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются))

Дата введения в учебный процесс УлГУ: **«01» сентября 2022 г.**


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Махмуд-Ахунов М.Ю.	Кафедра физического материала- ловедения	к.ф.-м.н., доцент кафедры

СОГЛАСОВАНО	
Заведующий выпускающей кафедрой физиче- ского материаловедения	
	/ В.Н.Голованов /
«15» апреля 2022г.	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний об электронных компонентах, входящих в электронные приборы.


Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с основными методами изучения средств микро- и нанoeлектроники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавра по направлению 28.03.02 «Нанотехнологии». В ней рассматриваются вопросы теории и практики изучения электронных средств. Дисциплина читается в 7 и 8 семестре 4-ого курса студентам очной формы обучения и базируется на отдельных компонентах компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин учебного плана:

- Диагностика полупроводниковых структур
- Материаловедение
- Материаловедение наноматериалов и наносистем
- Методы диагностики в нанотехнологиях
- Методы и средства измерений и контроля
- Механика материалов и основы конструирования
- Нанометрология
- Нанoeлектроника
- Научно-исследовательская работа
- Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
- Ознакомительная практика
- Основы надежности технических систем
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
- Прикладная механика
- Проектная деятельность
- Системы управления технологическими процессами
- Сопротивление материалов
- Структура и свойства металлических наноматериалов
- Технологическая (проектно-технологическая) практика
- Электротехника и электроника

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для для прохождения производственной и преддипломной практик, государственной итоговой аттестации.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ОПК-3 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные	Знать: различные виды испытаний, проводимых для электронных средств, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимого объема информации о характеристиках свойств электронных компонент Уметь: проводить анализ результатов исследований, включая построение математических моделей объекта исследований Владеть: навыками использования различных измерительных схем.
ПК-2 Освоение конструктивных особенностей и режимов работы оборудования по производству наноматериалов и наноструктур	Знать: принципы выбора и составление плана эксперимента; организации эксперимента и проведение измерений отклика объекта исследований Уметь: практически проводить однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ, корреляционный и регрессионный анализы Владеть: навыками работы на испытательном оборудовании
ПК-4 Проведение испытаний наноматериалов и наноструктур на измерительном оборудовании с целью выявления функциональных свойств и контроля качества	Знать: рациональное планирование, экстремальное планирование, построение эмпирических моделей по данным активного эксперимента, даны планы дробного факторного эксперимента, обработка результатов эксперимента Уметь: экспериментально определять количественные и качественные характеристики свойств электронных компонент как результата различных видов воздействий Владеть: современными методами планирования, организации и оптимизации промышленного эксперимента

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 7 З.Е.

4.2. По видам учебной работы (в часах): 252

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		


Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очная)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		1-6	7	8
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	102/102	-	54/54	48/48
Аудиторные занятия:				
• Лекции (в т.ч. 0 ПрП)*	34/34	-	18/18	16/16
• семинары и практические занятия (в т.ч. 0 ПрП)*	34/34	-	18/18	16/16
• лабораторные работы, практикумы (в т.ч. 0 ПрП)*	34/34	-	18/18	16/16
Самостоятельная работа	114/114	-	54/54	60/60
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам, доклады	-	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам, доклады	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам, доклады
Курсовая работа	-	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Зачет/Экзамен 36	-	Зачет	Экзамен (36/36)
Всего часов по дисциплине	252/252	-	108/108	144/144

В случае перехода на дистанционную форму обучения все часы реализуются в полном объеме.

4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения – очная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		лекции	практические занятия, семинары	лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
7 семестр							
Тема 1. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем	12	6	6	6	6	6	Устный опрос, отчет к лабораторной работе
Тема 2. Определение времени жизни нерав-	24	6	6	12	6	12	Устный опрос,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

новесных носителей тока							отчеты к лабораторным работам
Тема 3. Измерение характеристик и определение параметров транзистора	24	6	6	12	6	12	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам
8 семестр							
Тема 4. Изучение диодов Шоттки	24	6	6	6	6	12	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам
Тема 5. Влияние температуры на проводимость металлов и полупроводников.	12	6	6	6	6	6	Устный опрос, отчет к лабораторной работе
Тема 6. Механизмы протекания тока через р-п переход при высоком уровне инжекции.	12	4	4	4	4	6	Устный опрос, отчет к лабораторной работе
ИТОГО:	216	34	34	34	34	114	-

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем


Изучение параметров диодов, стабилитронов, транзисторов и микросхем по справочной литературе, приобрести навыки измерения параметров диодов, стабилитронов и маломощных транзисторов.

Тема 2. Определение времени жизни неравновесных носителей тока

Параметры фоторезистора: спектральная чувствительность, люкс-амперная характеристика, частотные свойства, время жизни неравновесных носителей тока. Процессы генерации и рекомбинации неравновесных носителей заряда в полупроводниках.

Тема 3. Измерение характеристик и определение параметров транзистора. Схема включения с общей базой. Схема включения с общим эмиттером

Тема 4. Изучение диодов Шоттки.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Физика контакта металл/полупроводник, метод вольт-фарадных характеристик, вольт-амперные характеристики диода Шоттки.

Тема 5. Влияние температуры на проводимость металлов и полупроводников.

Основы зонной теории твердых тел, температурная зависимость электропроводности металла и полупроводника (температурный коэффициент сопротивления металла, энергия активации полупроводника).

Тема 6. Механизмы протекания тока через *p-n* переход при высоком уровне инжекции.

Формирование тока через *p-n*-переход и базу диода при высоком уровне инжекции носителей заряда. Идентификация механизма переноса и определение параметров на основе измерения вольт-амперной характеристики.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)

Лабораторная работа №1. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем

Цель работы: изучить параметры диодов, стабилитронов, транзисторов и микросхем по справочной литературе, приобрести навыки измерения параметров диодов, стабилитронов и маломощных транзисторов.

Лабораторная работа №2. Определение времени жизни неравновесных носителей тока

Цель работы: Изучение параметров фоторезистора. Изучение вольт-амперной характеристики фоторезистора. Изучение спектральной чувствительности фоторезистора и его люкс-амперной характеристики. Изучение частотных свойств фоторезистора и определение времени жизни неравновесных носителей тока.

Лабораторная работа №3. Определение времени жизни неравновесных носителей заряда в полупроводниках методом модуляции проводимости точечного контакта


Целью работы является изучение процессов генерации и рекомбинации неравновесных носителей заряда в полупроводниках; ознакомление с методом модуляции проводимости точечного контакта; освоение методики определения времени жизни неравновесных носителей заряда в базе точечного полупроводникового диода, основанной на методе модуляции проводимости точечного контакта; проведение измерений времени жизни неравновесных носителей заряда.

Лабораторная работа №4. Измерение характеристик и определение параметров транзистора по схеме с общей базой

Цель работы: состоит в определении входных и выходных характеристик транзистора по схеме с общей базой и вычислении на этой основе h -параметров транзистора.

Лабораторная работа №5. Снятие статических характеристик и определение параметров транзисторов в схеме с общим эмиттером

Цель работы: научиться экспериментально определять входные, выходные статические характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Лабораторная работа №6. Изучение диодов Шоттки.

Цель работы: изучение физики контакта металл/полупроводник, освоить метод вольт-фарадных характеристик и определить основные параметры диодов Шоттки.

Лабораторная работа №7. Изучение электрофизических параметров диодов Шоттки

Цель работы – изучение вольт-амперных характеристик диода Шоттки, определение высоты потенциального барьера на границе металл-полупроводник.

Лабораторная работа №8. Влияние температуры на проводимость металлов и полупроводников.

Цель работы - изучить основы зонной теории твердых тел, исследовать температурную зависимость электропроводности металла и полупроводника, определить температурный коэффициент сопротивления металла и энергию активации полупроводника.

Лабораторная работа №9. Исследование механизмов протекания тока через p-n переход при высоком уровне инжекции

Цель работы – изучение механизма формирования тока через *p-n*-переход и базу диода при высоком уровне инжекции носителей заряда. Идентификация механизма переноса и определение параметров на основе измерения вольт-амперной характеристики.


8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ

7 семестр

1. Дайте определения следующих понятий: генерация, рекомбинация, захват, избыточная концентрация; неравновесная концентрация; низкий, высокий, средний уровень инжекции; время жизни.
2. Уравнение непрерывности, время жизни. Каким образом устанавливается электронейтральность в полупроводниках?
3. Как определяется время жизни неосновных носителей заряда в полупроводнике при условии существования параллельно нескольких механизмов рекомбинации?
4. Типы диодов. Конструкция и основные технические параметры диодов.
5. Биполярные транзисторы: конструкция, принцип действия и основные технические параметры транзисторов.
6. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ). Каков физический смысл h -параметров в схеме с ОБ? Графическое определение h -параметров по входным и выходным характеристикам.
7. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ). Почему коэффициент передачи тока эмиттера меньше единицы? ВАХ биполярного транзистора в схеме с общей базой.
8. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Чем объяснить усиление по току при включении транзистора с ОЭ? Какие зависимости определяют входные и выходные характеристики транзистора при включении с ОЭ?
9. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Каков физический смысл h -параметров в схеме с общим эмиттером ОЭ? Показать графическое определение h -параметров по входным и выходным характеристикам.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

10. Сравнение входных и выходных характеристик транзистора при различных схемах подключения. Нарисовать семейства ВАХ при схемах подключения ОЭ и ОБ.

8 семестр

11. Диод с барьером Шоттки: конструкция, принцип работы. Энергетическая диаграмма системы металл/полупроводник.

12. Метод определения среднего времени жизни неравновесных носителей тока в полупроводниках.

13. Как объясняются электрические свойства металлов, полупроводников и диэлектриков с точки зрения зонной теории?

14. Какова методика определения фактора неидеальности m и тока насыщения I_0 по экспериментальным ВАХ диодов Шоттки?


15. Что такое инжекция? Чем отличаются высокий и низкий уровень? Какие еще существуют способы создания неравновесных носителей?

16. Объяснить ВАХ p - n -перехода при высоком уровне инжекции


10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения: очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в часах	Форма контроля
Тема 1. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем	<ul style="list-style-type: none"> Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; Подготовка отчетов к лабораторным работам Подготовка к зачету 	6	Устный опрос, отчет к лабораторной работе
Тема 2. Определение времени жизни неравновесных носителей тока	<ul style="list-style-type: none"> Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; Подготовка отчетов к лабораторным работам Подготовка к зачету 	12	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам
Тема 3. Измерение характеристик и определение параметров транзистора	<ul style="list-style-type: none"> Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; Подготовка отчетов к лабораторным работам Подготовка к зачету 	12	Устный опрос, отчеты к лабораторным работам
Тема 4. Изучение диодов Шоттки	<ul style="list-style-type: none"> Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- 	12	Устный опрос, отчеты к

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

	<p>методического и информационного обеспечения дисциплины;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка отчетов к лабораторным работам • Подготовка к зачету 		лабораторным работам
Тема 5. Влияние температуры на проводимость металлов и полупроводников.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка отчетов к лабораторным работам • Подготовка к зачету 	6	Устный опрос, отчет к лабораторной работе
Тема 6. Механизмы протекания тока через р-п переход при высоком уровне инжекции.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка отчетов к лабораторным работам • Подготовка к зачету 	6	Устный опрос, отчет к лабораторной работе

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная литература

1. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов / В. И. Старосельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0808-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/509181>
2. Авдеев, С. П. Краткий обзор теории полупроводниковых структур : учебное пособие / С. П. Авдеев. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 118 с. — ISBN 978-5-9275-2721-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87431.html>

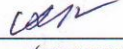
дополнительная литература


1. Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие / Д. Я. Вострецов [и др.]; УлГУ, ИФФВТ, Каф. инженерной физики. - Ульяновск : УлГУ, 2019. – Режим доступа: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1453>
2. Основы диагностики полупроводниковых структур : учебное пособие / Д. Я. Вострецов, Л. Н. Вострецова, Д. А. Богданова [и др.]; УлГУ, ИФФВТ, Каф. инженерной физики. - Ульяновск : УлГУ, 2018. – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1477>
3. Филимонова, Н. И. Методы электронной микроскопии : учебное пособие / Н. И. Филимонова, А. А. Величко, Н. Е. Фадеева. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 61 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/69545.html>

Учебно-методические рекомендации

1. Василевская Т. М. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Диагностика полупроводниковых структур» / Т. М. Василевская; УлГУ, ИФФВТ. - Ульяновск : УлГУ, 2021. - 7 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/10964>

Согласовано:

Ведущий специалист ООП НБ УлГУ / Чамеева А.Ф. /  / _____ 2022
(Должность работника научной библиотеки) (ФИО) (подпись) (дата)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

б) **Программное обеспечение:** Мой Офис Стандартный, ОС Альт Рабочая станция 8

в) **Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы:**

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи Ар Медиа. - Саратов, [2021]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2021]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2021]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг. – Москва, [2021]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2021]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2021]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. **Znanium.com** : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2021]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.8. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, медицинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=9f57a3e1-1191-414b-8763-e97828f9f7e1%40sessionmgr102> . – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

1.9. Русский язык как иностранный : электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». – Саратов, [2021]. – URL: <https://ros-edu.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2021].


3. Базы данных периодических изданий:

3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - Москва, [2021]. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО Научная Электронная Библиотека. – Москва, [2021]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2021]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры РФ ; РГБ.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

– Москва, [2021]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. [SMART Imagebase](https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741) // EBSCOhost : [портал]. – URL: <https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Изображение : электронные.

6. Федеральные информационно-образовательные порталы:

6.1. [Единое окно доступа к образовательным ресурсам](http://window.edu.ru/) : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://window.edu.ru/>. – Текст : электронный.

6.2. [Российское образование](http://www.edu.ru) : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

7. Образовательные ресурсы УлГУ:

7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, для выполнения лабораторных работ, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса, размещёнными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

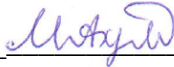
– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации;

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик  доцент, Махмуд-Ахунов Марат Юсупович
подпись должность, ФИО